Si-npn-NF-Transistoren mittlerer Leistung
n-p-n middle power AF Si-transistors

Typ	Grenzdaten max. ratings bei at $\vartheta_a = -55 \ldots +125\,°C$					elektr. Kenndaten electrical characteristics bei at $\vartheta_a = 25\,°C$							
	P_{tot} [3]	U_{CBO}	U_{CEO}	U_{EBO}	I_C	h_{21E} [4]	bei/at U_{CE}	I_C	f_T [2]	U_{CEsat} [1]	U_{BEsat} [1]	I_{CBO}	bei/at U_{CB}
	W	V	V	V	A		V	mA	MHz	V	V	nA	V
SD 335	12,5	45	45	5	1,5	40 ... 250	2	150	130	<0,5	<0,9	<100	30
SD 337	12,5	60	60	5	1,5	40 ... 250	2	150	130	<0,5	<0,9	<100	30
SD 339	12,5	80	80	5	1,5	40 ... 250	2	150	130	<0,5	<0,9	<100	30

Si-pnp-NF-Transistoren mittlerer Leistung
p-n-p middle power AF Si-transistors

Typ	Grenzdaten max. ratings bei at $\vartheta_j = -55 \ldots +125\,°C$					elektr. Kenndaten electrical characteristics bei at $\vartheta_a = 25\,°C$							
	P_{tot} [3]	$-U_{CBO}$	$-U_{CEO}$	$-U_{EBO}$	$-I_C$	h_{21E} [4]	bei/at $-U_{CE}$	$-I_C$	f_T [2]	$-U_{CEsat}$ [1]	$-U_{BEsat}$ [1]	$-I_{CBO}$	bei/at $-U_{CB}$
	W	V	V	V	A		V	mA	MHz	V	V	nA	V
SD 336	12,5	45	45	5	1,5	40 ... 250	2	150	190	<0,5	<0,9	<100	30
SD 338	12,5	60	60	5	1,5	40 ... 250	2	150	190	<0,5	<0,9	<100	30
SD 340	12,5	80	80	5	1,5	40 ... 250	2	150	190	<0,5	<0,9	<100	30

[1] $|I_C| = 500\,mA$; $|I_B| = 50\,mA$
[2] $|U_{CE}| = 10\,V$; $|I_C| = 50\,mA$; $f = 20\,MHz$
[3] $\vartheta_a \leq 25\,°C$
[4] Selektiert nach Stromverstärkungsgruppen
selected by current-gain groups

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)

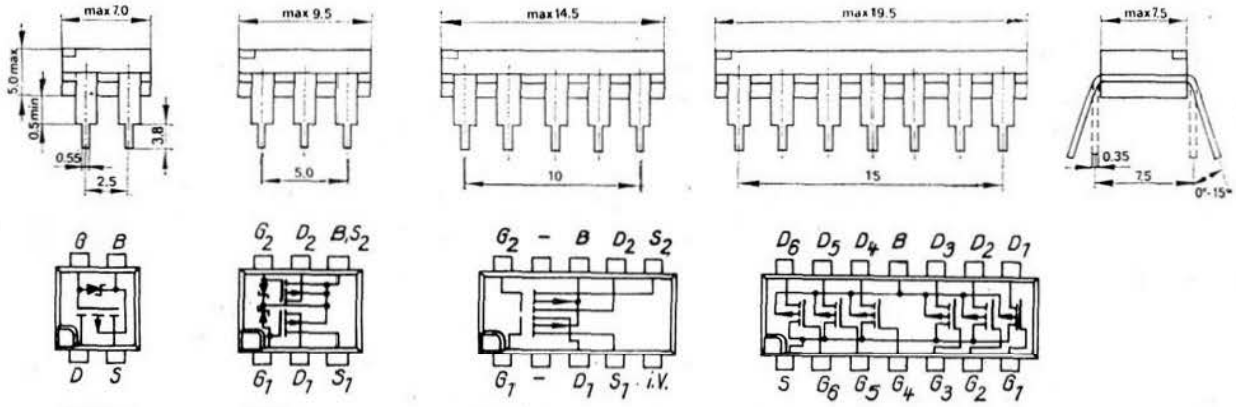
Typ	Grenzdaten max. ratings bei at $\vartheta_a = 25\,°C$							Informationsdaten electrical characteristics bei at $\vartheta_a = 25\,°C$				
	P_{tot}	U_{DS}	bei at $-U_{GS}$	U_{GS}	U_{DG}	I_D	I_D	Y_{21}	bei at U_{DS}	$-U_T$	bei at I_D	R_e
	mW	V	V	V	V	mA	mA	mS	V	V	µA	TΩ
SM 103	150	20	12	−15/+5	32	15	3 ... 12	>1,3	8	<12	10	>1
SM 104	150	20	10	−15/+5	30	15	1,5 ... 6,5	>1,0	8	<8	10	>1

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (p-channel enhancement-type)

Typ	Grenzdaten max. ratings bei at $\vartheta_a = 25\,°C$							Informationsdaten electrical characteristics bei at $\vartheta_a = 25\,°C$					
	P_{tot} mW	U_{DS} U_{DB} V	U_{GS} U_{DG} V	U_{DG} V	U_{SB} V	$-I_D$ I_{DRM} * mA	$-I_D$ mA	Y_{21} mS	bei at $-U_{DS}$ V	$-U_T$ V	bei at $-I_D$ µA	C_{ges} pF	R_{DS} Ω
SMY 50	225	−31/+0,3	−31/+0,3	±31	−15/+0,3	25	10	2	10	3 . . . 6	10	<12	150
SMY 51 [1]	240	−31/+0,3	−31/+0,3	±31	0	20	12	2	10	3 . . . 6	10	<12	150
SMY 52	300	−31/+0,3	−31/+0,3	±31	−15/+0,3	60 120 *	50	12,5	10	3 . . . 6	10	<38	35
SMY 60 [3]	240	−25/+0,3	−25/+0,3	±25	−15/+0,3	20				>2,8	10	<10	
U 105 D [2]	400	−31/+0,3	−31/+0,3	±31	0	25	>3		2	3 . . . 6	10	<12	150

[1] Doppeltransistor
[2] 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis)
[3] Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, getrennter Substratanschluß

[1] dual transistor
[2] six-transistor MOS circuit
[3] dual transistor without gate protecting diodes with isolated bulk connexion

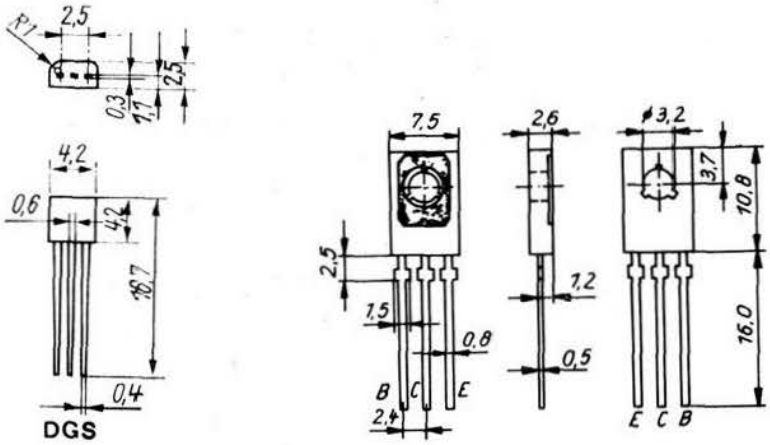


SMY 50
SMY 52

SMY 51

SMY 60

U 105 D



SM 103, SM 104

SD 335 D . . . SD 340 D